

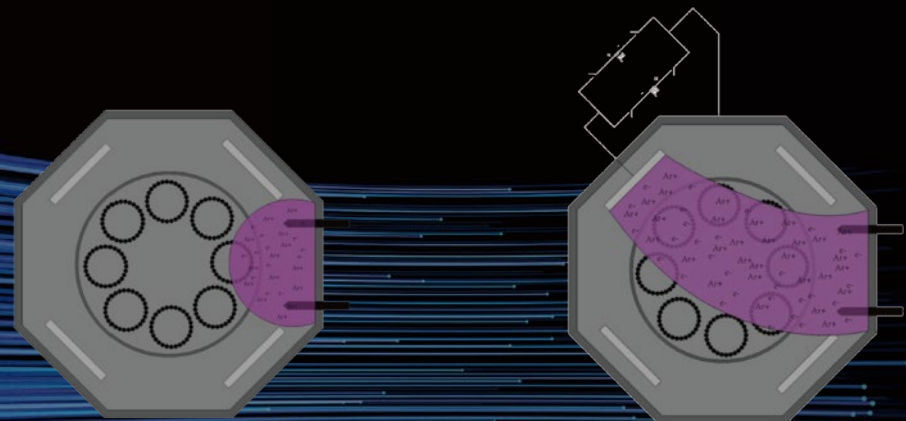
刻蚀清洗系统

SET[®] Side Etching Technology

侧向氩离子辉光放电清洗系统，等离子体辉光区域集中，清洗复杂的表面结构更高效，如：杆状刀具或齿轮加工刀具等。

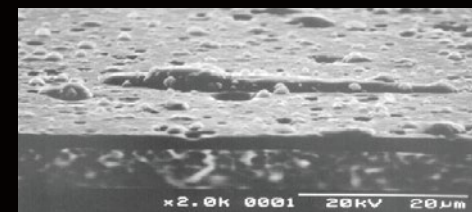
CET[®] Cross Etching Technology

贯穿式氩离子辉光放电清洗系统，等离子体穿透工件有效区域，辉光放电区域分布更宽，清洗复杂表面结构更均匀。如：大型腔的模具等。



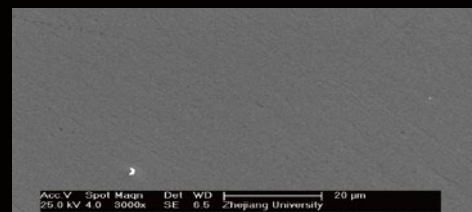
CVC[®] 连续可变阴极

纳狮专利 CVC[®] 阴极技术基于高磁场强度的永磁和电磁相结合的特殊设计，通过电磁场强度的不断变化，在靶材表面进行扫描，从而获得稳定的涂层性能与高的靶材利用率。



UFC[®] 超细阴极

纳狮专利 UFC[®] 阴极技术基于低磁场强度的永磁铁和高磁场强度的磁线圈相结合。磁线圈的频率不断变化，在电弧靶材表面定向扫描，过滤掉大部分的液滴，获得低粗糙度、高致密性的涂层。



纳狮新材料有限公司

浙江省平湖市经济开发区兴平二路1661号
邮编：314200

Tel: 0573 8507 1366
Fax: 0573 8507 1367

我们的全球涂层中心官网为
www.naxau.com

PVD 表面涂层 解决方案

WWW.NAXAU.COM

Naxau

纳狮核心 刻蚀技术

M 系列

刀工具、模具涂层设备



新一代阴极电弧技术

M 系列是基于纳狮 SPARK® 平台设计, 具有 CVC® (连续可变阴极技术) 和 UFC® (超精细阴极技术) 专利的电弧阴极关键技术的一款产品。SPARK® 平台具有高度的灵活性, 是业界最可靠的生产输出之一。多种等离子体技术可以在一台机器上结合使用。

| M 系列 | M450 | M600 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 有效涂层区域(mm) | D680x450 | D680x600 |
| 最大载重(kg) | 300 | 500 |
| PVD技术 | CVC or UFC | CVC® or UFC® |
| 刻蚀技术 | SET® or CET® | SET® or CET® |
| 涂层种类 | 所有刀工具、模具涂层 | 所有刀工具、模具涂层 |
| 复合技术 | 可做升级 | 可做升级 |
| 阴极数量 | 6 | 10 |
| 最小表面粗糙度(Ra) | Ra0.05 (需要匹配 UFC®) | Ra0.05 (需要匹配 UFC®) |
| 占地面积D*W*H (mm) | 4600x2300x2000 | 4600x2300x2000 |

新一代 PECVD 和溅射技术

P 系列是基于纳狮 SPARK® 平台设计, 具有 SET® (侧向等离子增强技术) 和 CFS® (闭合磁场磁控溅射技术) 专利的等离子技术。SPARK® 平台具有高度的灵活性, 是业界最可靠的生产输出之一。多种等离子体技术可以结合在一台机器上。

| P 系列 | P850 | P1200 |
|----------------|---|---|
| 有效涂层区域(mm) | D680x850 | D680x1200 |
| 最大载重(kg) | 1000 | 1500 |
| PVD技术 | PECVD和磁控溅射 | PECVD和磁控溅射 |
| 刻蚀技术 | SET® or CET® | SET® or CET® |
| 涂层种类 | CrN, a-C:H, a-C:Si:H, DLC, WCC, ta-C | CrN, a-C:H, a-C:Si:H, DLC, WCC, ta-C |
| 复合技术 | 可做升级 | 可做升级 |
| 阴极数量 | 4 | 4 |
| 最小表面粗糙度(Ra) | Ra0.05 | Ra0.05 |
| 占地面积D*W*H (mm) | 4600x2300x2200 | 4600x2300x2400 |



P 系列

零部件 DLC 设备



基于超过 20 年的持续运行和改进, Naxau 已经开发了一种专利的等离子体刻蚀技术 SET® 和 CET®。在镀膜之前, 对工具表面进行适当的刻蚀以达到清洁和活化的界面, 对于成功的涂层结果至关重要。刻蚀需要去除表面污染物, 如金属氧化物、水汽、微油和汗液碎片等。刻蚀也可以重新激活表面, 打开分子链, 促使涂层过程中离子键结合。

纳狮的 SET® 和 CET® 技术在镀膜过程中也可作为气体等离子体源使用。对于用于工具的 M 系列 PVD 涂层设备, SET® 和 CET® 技术可以使工具涂层的硬度提高 30% 以上。对于用于零部件的 PECVD 镀膜设备, SET® 和 CET® 技术将进一步电离 C2H2、CH4、SiH4 等入口气体, 以实现 DLC 涂层更好的结晶和更高的硬度。